PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-084389

(43) Date of publication of application: 25.06.1980

(51)Int.CI.

C09K 11/475

(21)Application number : **53-159449**

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO

LTD

KASEI OPTONIX CO LTD

(22)Date of filing:

21.12.1978

(72)Inventor:

MIYAHARA JUNJI MATSUMOTO SEIJI KATO HISATOYO KODERA NOBORU

EGUCHI SHUSAKU

(54) FLUORESCENT SUBSTANCE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain cerium-activated barium fluorohalide fluorescent substance giving a stimulated luminescence of high brightness by adding one or more of In, Tl, Sn, Gd, and Zr as the co-activator of Ce.

CONSTITUTION: BaF2 is mixed with one or more halides of BaCl2, BaBr2, NH4I, etc., one or more Ce compounds of Ce(NO3)3, CeCl3 etc., and one or more compounds of the chlorides, fluorides, etc., of In, Tl, Sn, Zr, and Gd in such a proportion as to obtain BaFX:xCe, yA, (wherein X is Cl, Br, or I, A is In, Tl, Sm, Gd, or Zr, and x and y are in the relationship $0 < x \le 2 \times 10^{-1}$, $0 < y \le 5 \times 10^{2}$, and then the mixture is filled in a heat-resistant container, baked at $600W1,000^{\circ}$ C in a weakly reductive atmosphere, ground, washed with cold water or an organic solvent at 15° C or less to obtain Ce-activated barium fluorohalide fluorescent substance.

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55—84389

⑤Int. Cl.³C 09 K 11/475

識別記号

庁内整理番号 7003-4H 砂公開 昭和55年(1980)6月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

匈螢光体

②特 願 昭53-159449

②出 願 昭53(1978)12月21日

⑩発 明 者 宮原諄二

南足柄市中沼210番地富士写真 フイルム株式会社内

@発 明 者 松本誠二

南足柄市中沼210番地富士写真 フイルム株式会社内

⑰発 明 者 加藤久豊

南足桥市中沼 210番 地富士写真

フイルム株式会社内

⑰発 明 者 小寺昇

小田原市中町1-1-1-905

@発 明 者 江口周作

小田原市飯泉220-1

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式会社

南足柄市中沼210番地

⑪出 願 人 化成オプトニクス株式会社

東京都港区浜松町2丁目7番18

号

個代 理 人 弁理士 柳田征史 外1名

明 細 株

1. 発明の名称 螢光体

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 組成式が

BaFX: xCe, yA

(但 し X は 塩 素 、 臭 素 お よ び 沃 素 の う ち の 少 な く と も 1 種 、 A は イ ン ジ ウ ム 、 タ リ ウ ム 、 ガ ド リ = ウ ム 、 サ マ リ ウ ム お よ び ジ ル コ = ウ ム の う ち の 少 な く と も 1 種 で あ り 、 × お よ び y は そ れ ぞ れ 0 < x ≤ 2 × 1 0 ⁻¹ および 0 < y ≤ 5 × 1 0 ⁻² なる 条件を 満 た す 数 で ある)

で表わされるフロロハロゲン化パリウム螢 光体。

- (2) 前記×が10⁻⁶≤×≤5×10⁻³ なる 条件を満たす数であることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載のフロロハロゲン 化パリウム螢光体。
- (3) 前記 y が 1 0 ⁻⁵ ≤ y ≤ 1 0 ⁻³ たる条件 を満たす数であることを特徴とする特許請

1.

求の範囲第 1 項記載のフロロハロゲン化パリウム螢光体。

- 2 -

3. 発明の詳細な説明

本発明は螢光体、さらに詳しくはフロロハロゲン化バリウム螢光体に関する。

ある種の螢光体は電離放射線、紫外線、 電子譲等の照射を受けた後、可視光あるい は赤外線の照射を受けると螢光を発する。 との現象は「輝尽」と呼ばれ、輝尽を示す **螢光体は「輝尽性螢光体」と呼ばれる。輝** 、尽性發光体は、蓄積型放射線像変換器として 利用することができることが知られている 。すなわち、輝尽性螢光体からなる螢光体 層に被写体を透過した放射線を吸収せしめ 、その後可視光あるいは赤外線を螢光体層 に照射するととによって輝尽性螢光体が蓄 **植した放射線エネルギーを螢光として放射** させ、それを検出することによって被写体 の放射線像を得るととができる。蓄積型放 射線像変換器を実用するにあたっては被写 体は人である場合が多く、従って被写体の 被曝線量をできるだけ軽減させることが必

- 3 -

ン化パリウム螢光体を提供することを目的と するものである。

本発明の強光体は組成式が

BaFX: x Ce, y A

(但しXは塩菜、臭素および沃素のうちの少なくとも1額、 Aはインジウム、タリウム、ガドリニウム、サマリウムおよびジルコニウムのうちの少なくとも1種であり、×およびyはそれぞれ0<×≤ 2×10⁻¹ および0<y≤5×10⁻² 特開昭55-84389(2)

要とされる。この点から蓄積型放射線像変換 器に用いられる輝尽性螢光体としては輝尽の 発光輝度がより高いものが要望される。

従来輝尽性 螢光体の 1 つとして、その 組成式が

BaFX: x Ce

(但しXは塩素、臭素および沃素のうちの 少なくとも1種であり、×は0 < × ≤

2×10⁻¹ なる条件を満たす数である)
で表わされるセリウム付活フロロハロゲン化パリウム螢光体が知られている(特顧昭 5 3-8 4 7 4 4 号参照)。このセリウム付活フロロハロゲン化バリウム螢光体を蓄積型放射線像変換器に用いるにあたっては、上述のような状況からより高輝度の輝尽発光を示すセリウム付活フロロハロゲン化バリウム螢光体が望まれている。

従って本発明は従来のセリウム付活フロロハロゲン化パリウム螢光体よりもより高輝度の輝尽発光を示すセリウム付活フロロハロゲ

- 4 -

なる条件を満たす数である)

で表わされるものである。 輝尽による発光 輝度 の点から上記組成式の \times 値および y 値のより好ましい範囲はそれぞれ、 $10^{-6} \le x \le 5 \times 10^{-3}$ および $10^{-5} \le y \le 10^{-3}$ である。

本発明の螢光体はX線、r線等の電離放射祭 800nmの砂光ではX線、r線等の電離放射 800nmの砂波を照射した後と発光体は ででは、rのでは、rのでは、rのでは、rのでは、rのでは、rのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのででは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、roのでは、ro

上記組成式で表わされる本発明の螢光体は以 下に述べる製造方法によって製造される。

先ず螢光体原料としては

- i)弗化パリウム(BaFっ)
- ii)塩化パリウム (BaCl2)、臭化パリウム

- 5 --

特開昭55-84389(3)

(BaBr₂)、 沃化パリウム (BaI₂) 、塩化アンモニウム (NH₄Cℓ)、臭化アンモニウム (NH₄Br)_、および沃化アンモニウム (NH₄I) からなるハロゲン化物の 1 極もしくは 2 種以上、

1

- iii) 硝酸セリウム (Ce (NO₃)₃)、塩化セリウム (Ce Ce₃)、酸化セリウム (Ce₂O₃)等のセリウム化合物の 1 種もしくは 2 穂以上、および
- iv) 塩化物、弗化物、臭化物、硝酸塩、酸化物等のインジウム化合物、タリウム化合物、ガドリ=ウム化合物、サマリウム化合物がよびジルコ=ウム化合物からなる化合物群から遊ばれる化合物の1種もしくは2種以上

が用いられる。上記各登光体原料を化学量論 的に

BaFX: x Ce, y A.

(但しXは塩素、臭素および沃素のうちの少なくとも1額、Aはインジウム、タ

- 7 -

Te.

は1乃至6時間が適当である。焼成は空気中 で行をつてもよいが、アルゴンガス雰囲気、 窒素ガス雰囲気等の中性雰囲気あるいは炭素 雰囲気、少量の水素ガスを含む窒素ガス雰囲 気等の弱質元性雰囲気中で焼成するのが好ま しい。なお、上記焼成条件で一度焼成した後 焼成物を電気炉外に取り出し、粉砕した後同 一条件で再焼成を行なえば得られる螢光体の 発光雄度をさらに高めることができる。焼成 後得られる焼成物を粉砕し、その後洗浄、乾 燥、篩分け等の登光体製造において一般に採 用されている各種操作を行なつて本発明の登 光体を得る。なお、本発明の登光体は温水で 分解し易いので、その洗浄は冷水(15℃以 下)あるいはアセトン、酢酸エチル、エチル アルコール等の有機溶剤で行なり。

上述のようにして製造される本発明のフロロハロゲン化バリウム登光体は従来のセリウム付活フロロハロゲン化バリウム登光体より も高輝度の輝尽発光を示し、また高輝度の瞬 リウム、ガドリニウム、サマリモウムおよび ジルコニウムのうちの少なくとも 1 聴であり 、×および y はそれぞれ 0 <× ≤ 2 × 10⁻¹ および 0 < y ≤ 5 × 1 0⁻² なる条件を満た す数である。以下同様である)

たる混合組成式となるように秤躍し、ボールミル、ミキサーミル等を用いて充分に混合する。ここで登光体原料の1つとしてハロゲン化アンモニウム(NH₄ X)を用いる場合は上記化学最齢量以上の過剰のハロゲン(X)が原料混合物中に存在しうる場合もあるが、これら過剰のハロゲン(X)は以下に述べる焼成の過程でNH₄ X として反応系外へ散逸する。

次に上記原料混合物をアルミナルツボ、石 英ルツボ等の耐熱性容器に充塡して電気炉中で焼成を行なう。焼成温度は 600 乃至1000 でが適当であり、好ましくは 700 乃至 900 でである。焼成時間は原料混合物の充塡量、 採用する焼成温度等によって異なるが一般に

- 8 -

. ...

時発光および熱盤光を示す。

第1図は本発明の盤光体の1つである
BaFBr:0.0005Ce,0.0001Sm 盤光体に80 KVpのX線を照射した後He - Ne レーザー光で励起した場合の輝尽の発光スペクトルである。第1図から明らかなように、本発明のBaFBr:Ce,Sm 盤光体はおよそ390 nm にピークを有する近紫外乃至育色の輝尽発光を示す。なお、このBaFBr:Ce,Sm 盤光体をX線、電子線、紫外線等で励起した時の瞬時発光の発光スペクトルも第1図に示される発光スペクトルとほぼ同様であつた。

第2図は本発明の螢光体の1つであるBaFBr:0.0005Ce,0.0001Sm. 螢光体に管電圧80 KVpのX線を照射した後波長の異なる光エネルギーを照射した場合の輝尽による発光強度の変化を示したもの、すなわちBaFBr:0.0005Ce,0.0001Sm 螢光体の輝尽の励起スペクトルである。第2図から明らかなように、BaFBr:Ce,Sm 螢光体はおよそ450 乃至800nm

の 放 長 の 光 で 励 起 し た 場 合 に 輝 尽 発 光 を 示 し、 と の 族 長 範 囲 内 で も 特 に お よ そ 4 5 0 乃 至 7 00 n m の 族 長 の 光 で 励 起 し た 場 合 に 高 輝 度 の 毎 尽 発 光 を 示 す 。

上述第1図および第2図はそれぞれ本発明 の BaFBr:Ce,Sm 螢光体についての輝尽の発光 および励起スペクトルであるが、セリウムの 共付活剤(A)がインジウム、タリウム、ガ ドリニウムあるいはジルコニウムである場合 あるいはインジウム、タリウム、ガドリニウ ム、サマリウムおよびジルコニウムのうちの 2種以上からなる場合、および盤光体母体成 分であるハロゲン (X) が塩素あるいは沃素 である場合あるいは塩素、臭素および氏素の **りちの2種以上からなる場合も輝尽の発光お** よび励起スペクトルは第1回および第2回に 示される BaFBr:Ce,Sm 螢光体の場合とほぼ同 様であつた。なお、従来のBaFX:Ce 螢光体の 輝尽の発光および励起スペクトルも第1図お よび第2図に示される BaFBr:Ce,Sm 螢光体の

- 11 -

10⁵≤ y ≤ 10⁻³ である場合により — 層高輝 度の雌尽発光を示す。なお、第3図は BaFBr の発光強度との関係を示すグラフであるが、 ×値が変化した場合、およびセリウムの共付 活剤(A)がインジウム、タリウム、ガドリ ニウムあるいはジルコニウムである場合ある いはインジウム、タリウム、ガドリニウム、 サマリウムおよびジルコニウムのうちの2種 以上からなる場合もy値と輝尽の発光強度と の関係は第3図とほぼ同様の傾向にあること が確認された。また螢光体母体成分であるハ ロゲン(x)が塩素あるいは沃素である場合 あるいは塩素、臭素をよび氏素のうちの2種 以上からなる場合もy値と輝尽の発光強度と の関係は第3図とほぼ同様の傾向にあること が確認された。

本発明のフロロハロゲン化バリウム螢光体におけるセリウム付活量(x値)範囲はセリウムのみを付活した従来のフロロハロゲン化

特開昭55-84389(4)

場合とほぼ同様である。このことから本発明の登光体においてセリウムの共付活剤として用いられるインジウム、タリウム、ガドリニウム、サマリウムおよびジルコニウムのうちの少なくとも1種はセリウムの増感剤として作用しているものと考えられる。

- 12 -

ベリウム 登光体の場合と同じく $0 < x \le 2 \times 10^{1}$ である。輝尽の発光輝度の点からより好ましい x 値範囲は $10^{6} \le x \le 5 \times 10^{2}$ である。

以上説明したように、本発明の螢光体はX 線、紫外線、電子線等を照射した後450万 至800 nm の波長の光で励起すると従来の セリウム付活フロロハロゲン化パリウム盤光 体よりも高輝度の輝尽発光を示す。従つて本 発明の抵光体を用いた蓄積型放射線像変換器 は従来のセリウム付活フロロハロゲン化パリ ウム螢光体を用いた放射線像変換器よりも高 感度である。また本発明の螢光体はX線、紫 外線、電子線等で励起した場合に高輝度の近 紫外乃至青色の瞬時発光を示すので、放射線 増感紙、登光ランプ、陰極線管等に利用する ことができる。さらに本発明の螢光体は X 線、 紫外線、電子線等で励起した後加熱すると高 輝度の熱螢光を示すので、熱螢光線量計等に 利用することができる。このように本発明の 工業的利用価値は非常に大きい。

次に実施例にようて本発明を説明する。 実施例 1.

弗化バリウム BaF2 175.39 97.98 臭化アンモニウム NH₄Br 硝酸セリウム Ce(NO₃)₃ 0.1639 .

0.0229

塩化インジウム InCla 上記各僚光体原料をポールミルで充分混合し た後、アルミナルツポに充填して電気炉に入 れ、炭素雰囲気中で800℃の温度で2時間 焼成した。焼成後ルッポを電気炉から取り出 し空気中で冷却した。得られた焼成物を粉砕 した後エチルアルコールで洗浄し、乾燥後 150メッシュの篩を通して粒子径をそろえ た。このようにして BaFBr: 0.0005Ce, 0.0001In 盤光体を得た。

との BaFBr: 0.0005Ce, 0.0001In 螢光体に 8 0 KVp の X 線を照射した後、 分光器にセットさ れたキセノンランプから発する光を回折格子 で分光して得た 6 3 0 nm の光でこの螢光体 を励起して輝尽の発光輝度を測定した。その

- 15 -

1...

の BaFBr: 0.0005Ce 螢光体の輝尽の発光障度の 約12倍であつた。

实施例 3.

BaF2 " 175.39 弗化バリウム 97.99 NH4Br 臭化アンモニウム 0.1639 Ce(NO₃)₃ 硝酸セリウム 0.0139 GdCe 3 塩化ガドリニウム

上記各登光体原料をポールミルで充分混合 した後、アルミナルツポに充塡し、以下実施 例 1 と同様にして BaFBr: 0.0005Ce, 0.00005Gd 盤光体を得た。

この BaFBr: 0.0005Ce,0.00005Gd 螢光体に80 KVpのX線を照射した後、分光器にセットさ れたキセノンランブから発する光を回折格子 で分光して得た 6 3 0 nm の光でとの螢光体 を励起して輝尽の発光輝度を測定した。その 結果、この螢光体の輝尽の発光輝度はピーク 値で比較した場合、同一条件で測定した従来 の BaFBr: 0.0005Ce 螢光体の輝尽の発光輝度の 約8.5倍であつた。

特開昭55-84389(5)

結果、この登光体の輝尽の発光輝度はピーク 値で比較した場合、同一条件で側定した従来 の BaFBr:: 0.0005Ce 螢 光体の輝尽の発光輝度の 約11倍であつた。

実施例 2.

弗化パリウム BaF₂ 175.39 臭化アンモニウム NH4Br 97.99 0.1639 Ce(NO₃)₃ 一硝酸セリウム SmCℓ3 0.0269 塩化サマリウム

上配各盤光体原料をポールミルで充分混合 した後、アルミナルツポに充塡し、以下実施 例 1 と同様にして BaFBr: 0.0005Ce, 0.0001Sm 登 光体を得た。

この BaFBr: 0.0005Ce, 0.0001Sm 盤光体に80 KVpのX線を照射した後、分光器にセットさ れたキセノンランプから発する光を回折格子 で分光して得た 6 3 0 nm の光でこの 登光体 を励起して輝尽の発光輝度を砌定した。その 結果、この螢光体の輝尽の発光輝度はピーク 値で比較した場合、同一条件で測定した従来

-1.6 -

実施例 4.

弗化バリウム 175.39 RaF₂ BaCez 208.29 塩化バリウム 硝酸セリウム Ce(NO₃)₃ 0.6529

0.0139 塩化サマリウム SmCl 3

上配各籔光体原料をポールミルで充分混合 した後、アルミナルツポに充填し、以下実施 例 1 と同様にして BaFCl: 0.001Ce, 0.00005 Sm **螢光体を得た。**

この BaFCl:0.001Ce,0.00005Sm 签光体に 8 0 KVpのX線を照射した後、この螢光体をHe -Ne レーザー光で励起して輝尽の発光輝度を 削定した。その結果、この签光体の輝尽の発 光輝度はピーク値で比較した場合、同一条件 で御定した従来の BaFC&: 0.001Ce 螢光体の輝 尽の発光輝度の約10.5倍であつた。 実施例5

> 175.39 弗化パリウム BaF 2 NH 4 Br 58.79 臭化アンモニウム NH4C& 21.49 塩化アンモニウム ・

> > - 18 -

塩化セリウム CeCls 0.0259 硝酸サマリウム Sm(NO₃)3 0.0179

、上記各簽光体原料をボールミルで充分混合 した後、アルミナルツボに充填し750℃で 3時間焼成する以外は実施例1と同様にして BaF(Cℓ o. , Bros): 0.0001Ce, 0.00005Sm 登光体を 得た。

この BaF(Cloa, Bros): 0.0001Ce, 0.00005Sm 登 光体に 80KVp の X 線を照射した後、この登光 体を He — Ne レーザー光で励起して輝尽の発 光輝度を 御定した。 その結果、この登光体の 輝尽の発光輝度はビーク値で比較した場合、 同一条件で 剛定した 従来の BaF(Cloa, Bros): 0.0001Ce 登光体の輝尽の発光輝度の約11倍 であつた。

実施例 6.

弗化パリウム	BaF ₂	175.39
臭化アンモニウム	NH4Br	97.90
硝酸セリウム	Ce(NO ₃) ₃	0.1639
硝酸タリウム	Teno:	0.0539

- 19 -

この BaFBr:0.0005Ce,0.0002Zr 螢光体に 8 0 KVp の X 線を照射した後、この終光体を HeーNe レーザー光で励起して輝尽の発光輝度を 副定した。その結果、この螢光体の輝尽の発光輝度はピーク値で比較した場合、 同一条件 で 測定した従来の BaFBr:0.0005Ce 螢光体の輝尽の発光輝度の約 4.5 倍であつた。

実施例 8.

弗化バリウム	BaF ₂	175.39
	Duly	173.39
臭化アンモニウム	NH 4 Br	97.98
硝酸セリウム	Ce(NO ₃) ₃	0.1639
硝酸サマリウム	Sm(NO ₃) ₃	0.0179
塩化インジウム	InC.	0.0044

上記各簽光体原料をポールミルで充分混合した後、アルミナルツポに充填し、以下実施例1と同様にしてBaFBr:0.0005Ce,0.00005Sm,0.00002In 螢光体を得た。

この BaFBr: 0.0005Ce, 0.00005Sm, 0.00002 In 螢光体に 80KVp の X 線を照射した後、この螢 光体を He — Ne レーザー光で励起して輝尽の 特開昭55-84389(6)

上記各签光体原料をポールミルで充分混合した後、アルミナルンポ化充塡し、以下実施例1と同様にしてBaFBr:0.0005Ce,0.0002T&登光体を得た。

との BaFBr: 0.0005Ce, 0.0002T& 登光体に 8 0 KVp の X 線を照射した後、 との登光体を HeーNe レーザー光で励起して輝尽の発光輝度を 測定した。その結果、 この登光体の輝尽の発光輝度はピーク値で比較した場合、 同一条件で 測定した従来の BaFBr: 0.0005Ce 登光体の輝尽の発光輝度の約 5 倍であつた。 実施例 7.

弗化バリウム BaF2 175.39
 臭化アンモニウム NH4Br , 97.99
 硝酸セリウム Ce(NO₃)₃ 0.1639
 硫酸ジルコニウム Zr(SO₄)₂ 0.0579

上記各僚光体原料をポールミルで充分混合した後、アルミナルツポに充填し、以下実施例1と同様にしてBaFBr:0.0005Ce,0.0002Zr 登光体を得た。

- 20 -

発光輝度を測定した。その結果、この螢光体の輝尽の発光輝度はピーク値で比較した場合、同一条件で測定した従来の BaFBr: 0.0005Ce 優光体の輝尽の発光輝度の約1 0.5 倍であつた。4.図面の簡単な説明

第1回は本発明の餐光体の輝尽の発光スペクトルである。

第2図は本発明の螢光体の輝尽の励起スペクトルである。

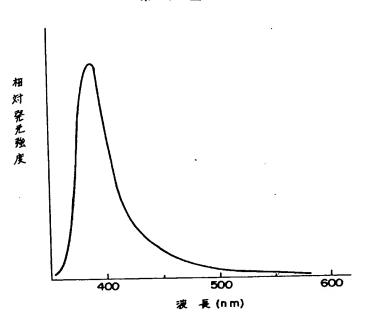
第3回は本発明の螢光体における共付活剤 掛(y値)と輝尽の発光強度との関係を示す グラフである。

特許出願人 富士写真フィルム株式会社 大日本強料株式会社

代 理 人 弁理士 物 田 征 史 外 1 名

- 21 - ·





第 2 図

